

# SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

ISSUE 4- JANUARY 1996

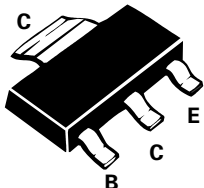
## FEATURES

- \* Low saturation voltage
- \* 300V  $V_{CEO}$

COMPLEMENTARY TYPE - FZT657

PARTMARKING DETAIL - FZT757

**FZT757**



## ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

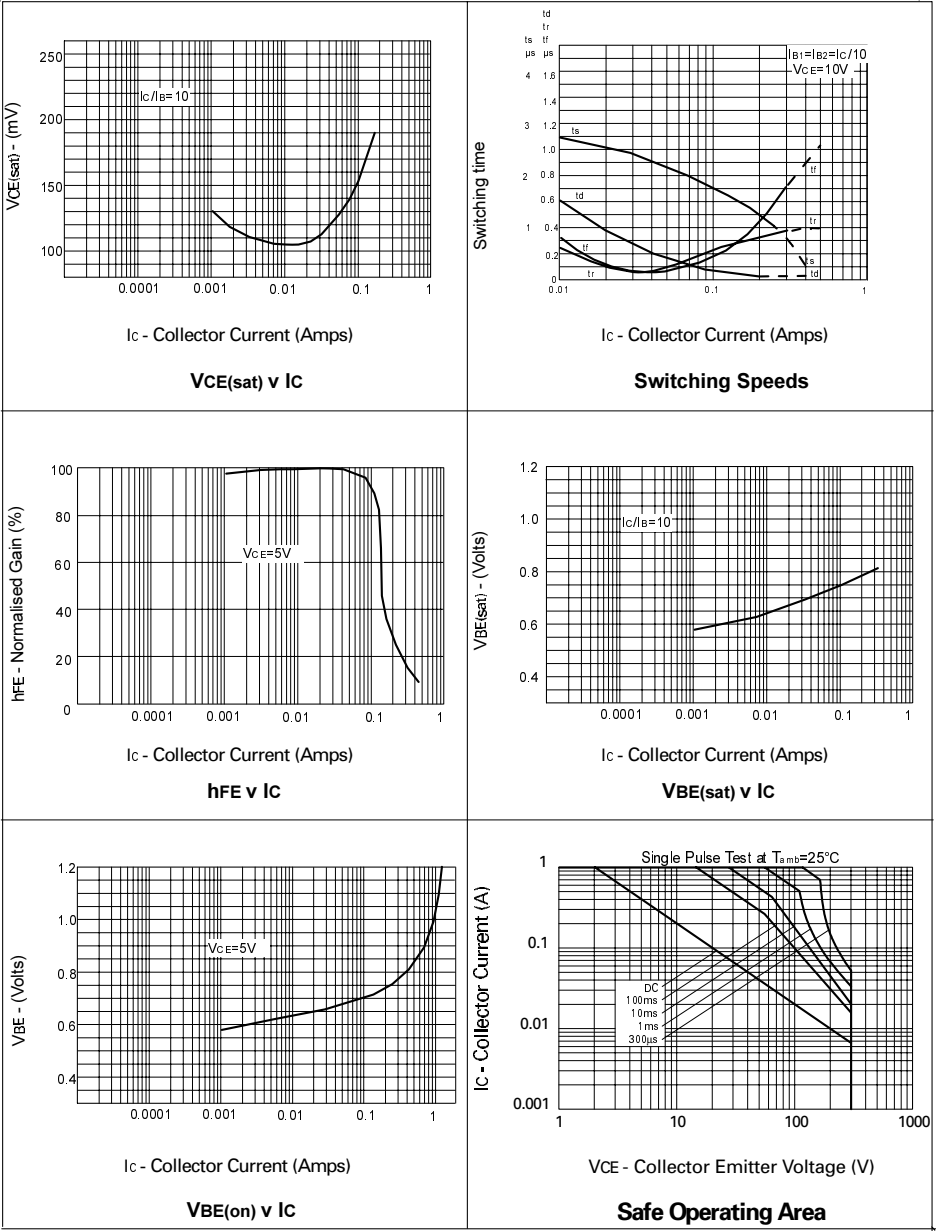
| PARAMETER                                  | SYMBOL         | VALUE       | UNIT        |
|--------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|
| Collector-Base Voltage                     | $V_{CBO}$      | -300        | V           |
| Collector-Emitter Voltage                  | $V_{CEO}$      | -300        | V           |
| Emitter-Base Voltage                       | $V_{EBO}$      | -5          | V           |
| Peak Pulse Current                         | $I_{CM}$       | -1          | A           |
| Continuous Collector Current               | $I_C$          | -0.5        | A           |
| Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$ | $P_{tot}$      | 2           | W           |
| Operating and Storage Temperature Range    | $T_j; T_{stg}$ | -55 to +150 | $^{\circ}C$ |

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

| PARAMETER                             | SYMBOL        | MIN.     | TYP. | MAX. | UNIT    | CONDITIONS.                                                     |
|---------------------------------------|---------------|----------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------|
| Collector-Base Breakdown Voltage      | $V_{(BR)CBO}$ | -300     |      |      | V       | $I_C = -100\mu A$                                               |
| Collector-Emitter Breakdown Voltage   | $V_{(BR)CEO}$ | -300     |      |      | V       | $I_C = -10mA^*$                                                 |
| Emitter-Base Breakdown Voltage        | $V_{(BR)EBO}$ | -5       |      |      | V       | $I_E = -100\mu A$                                               |
| Collector Cut-Off Current             | $I_{CBO}$     |          |      | -0.1 | $\mu A$ | $V_{CB} = -200V$                                                |
| Emitter Cut-Off Current               | $I_{EBO}$     |          |      | -0.1 | $\mu A$ | $V_{EB} = -3V$                                                  |
| Collector-Emitter Saturation Voltage  | $V_{CE(sat)}$ |          |      | -0.5 | V       | $I_C = -100mA, I_B = -10mA^*$                                   |
| Base-Emitter Saturation Voltage       | $V_{BE(sat)}$ |          |      | -1.0 | V       | $I_C = -100mA, I_B = -10mA^*$                                   |
| Base-Emitter Turn-On Voltage          | $V_{BE(on)}$  |          |      | -1.0 | V       | $I_C = -100mA, V_{CE} = -5V^*$                                  |
| Static Forward Current Transfer Ratio | $h_{FE}$      | 40<br>50 |      |      |         | $I_C = -10mA, V_{CE} = -5V^*$<br>$I_C = -100mA, V_{CE} = -5V^*$ |
| Transition Frequency                  | $f_T$         | 30       |      |      | MHz     | $I_C = -10mA, V_{CE} = -20V$<br>$f = 20MHz$                     |
| Output Capacitance                    | $C_{obo}$     |          |      | 20   | pF      | $V_{CB} = -20V, f = 1MHz$                                       |

\*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300 $\mu s$ . Duty cycle  $\leq 2\%$   
Spice parameter data is available upon request for this device

TYPICAL CHARACTERISTICS



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9